

## Подсекция

### ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ - Ауд. Конф. зал ЦКП

Определение степени окисления кремния и содержания кластеров кремния в пленках  $\text{SiO}_x$  методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии

Садчиков А.С., Паринова Е.В.

Влияние нанокристаллизации пленок  $\alpha\text{-Si:H}$ ,  $\text{SiO}$  и  $\text{Si}_3\text{N}_4$  на их электрофизические свойства  
Шулейко Д.В.

Фотопроводимость нанокристаллического оксида индия

Ситников И.А., Ильин А.С.

Электронно-лучевая эпитаксия слоев  $\text{SiC}$  и твердых растворов на его основе  $(\text{SiC})_{1-x}(\text{AlN})_x$

Касумов З.К.

Исследование лазерно-индуцированного разогрева кремниевых нанонитей методом спектроскопии комбинационного рассеяния света

Родичкина С.П.

Фото- и термостимулированная проводимость сульфоселенида кадмия, легированных рубидием

Билалов А.Б.

Формирование наночастиц кремния при абляции под действием фемтосекундных лазерных импульсов в атмосферах воздуха и гелия

Кашаев Ф.В.

Метод оценки положения единичного ловушечного заряда в оксидном слое наноразмерного МОП транзистора

Худайбергенов Т.А., Сапаров Х., Матякубов Х., Атамуратов Т.А.

Кремниевый нанопровод как основа высокочувствительных полевых и зарядовых сенсоров

Божьев И.В., Ржевский А.В., Корс А.Ю., Преснов Д.Е., Крупенин В.А.

Чувствительность фотолуминесцентных свойств кремниевых нанонитей к их молекулярному окружению

Георгобиани В.А.

Структурные и оптические свойства нанокристаллов кремния и карбида кремния, полученных прямым ионным осаждением

Федоренко А.А.